pC9

RAPPORT D'INTENSITE DES RAIES DE RESONANCE ET D'INTERCOMBINAISON EMISES PAR LES IONS Si¹²⁺ DANS DES PLASMAS CHAUDS DE HAUTES DENSITES

Kh. HADJARI et M.K. INAL

LPT, Département de Physique, Université A. Belkaïd – Tlemcen, B.P. 119, 13000 Tlemcen, Algérie E-mail: khad_phy@yahoo.fr

RÉSUMÉ: Les raies d'émission des ions fortement chargés à deux électrons sont fréquemment observées dans les spectres X des plasmas de hautes températures de laboratoire et d'astrophysique. Nous nous sommes intéressés dans ce travail aux raies de résonance w $(1s2p \ ^1P_1 \rightarrow 1s^2 \ ^1S_0)$ et d'intercombinaison y $(1s2p {}^{3}P_{1} \rightarrow 1s^{2} {}^{1}S_{0})$ émises par les ions silicium Si¹²⁺ dans un plasma chaud et relativement dense. Précisément, nous avons effectué des calculs poussés sur la dépendance en densité d'électrons N_e du rapport $\alpha = I_w / I_y$ de l'intensité de w sur celle de y dans un large domaine compris entre 10^{18} et 10^{23} cm⁻³. Diverses valeurs de la température électronique du plasma émissif, entre 10⁶ et 8×10⁶ K, on été considérées. Pour cela, nous avons déterminé les populations des niveaux supérieurs des deux raies w et y en appliquant un modèle collisionnelradiatif incluant dans un premier temps les 7 premiers niveaux de l'ion Si¹²⁺ (à savoir 1s² ¹S₀, 1s2s ³S₁, 1s2p ³P_{0,1,2}, 1s2s ¹S₀ et 1s2p ¹P₁), puis en rajoutant les dix niveaux plus excités associés aux configurations 1s3*l*. Nous avons tenté d'utiliser les meilleures données atomiques concernant les probabilités de transition radiative ainsi que les coefficients de taux d'excitation collisionnelle, soit disponibles dans la littérature soit évaluées par nous-mêmes en exploitant en-ligne des codes de calcul grâce au site web www-amdis.iaea.org. Nous avons retrouvé le caractère fortement sensible du rapport d'intensité α relatif à la densité N_e puisque nos résultats indiquent que pour la température de 4×10⁶ K, par exemple, α augmente de la valeur 1,7 à 258 lorsque N_e croit de 10¹⁸ à 10²³ cm⁻³. Les résultats de nos calculs de la dépendance du rapport α en N_e peuvent être appliqués à des plasmas produits par laser en vue de leur diagnostic en densité.

MOTS-CLÉS : plasmas chauds et denses, ions héliumoïdes, raies d'émission X, excitation collisionnelle, désexcitation radiative, diagnostic en densité d'électrons

I. Introduction :

Les ions hautement chargés de la série iso-électronique de l'hélium (c'est-à-dire des ions ayant deux électrons) sont généralement parmi les plus abondants dans les plasmas chauds à travers un large domaine de température du fait de leur structure électronique en couche fermés $(1s^2)$ qui les rend difficilement ionisables. Les raies émises dans le domaine X-mou par de tels ions lors des transitions $1s2l \rightarrow 1s^2$ (*l*=0,1) apparaissent parmi les plus intenses dans les spectres des plasmas chauds existant dans l'univers ou produits en laboratoire. Ces raies sont souvent utilisées pour les diagnostics de tels plasmas et, lorsqu'elles sont produites par des processus collisionnels, elles servent d'indicateurs fiables de température et de densité pour les électrons libres présents dans les plasmas. Elles peuvent également servir à déterminer l'équilibre d'ionisation des plasmas à travers le rapport d'abondance des états de charge héliumoïde et lithiumoïde d'un élément atomique.

Nous nous intéressons dans ce travail à l'intensité des deux raies w (de résonance) et y (d'intercombinaison) émises par des ions héliumoïdes de Z relativement petit dans des plasmas chauds et denses. Le rapport d'intensité de ces deux raies émises par un même élément est sensible à la densité des électrons dans un certain domaine de densité du fait de la nature métastables des deux niveaux $1s2s {}^{3}S_{1}$ et $1s2s {}^{1}S_{0}$. L'excitation collisionnelle à partir des ces niveaux excités peut jouer un rôle important dans le peuplement des niveaux 1s2p

 ${}^{3}P_{0,1,2}$ et 1s2p ${}^{1}P_{1}$, respectivement. Ceci est dû à la durée de vie radiative des niveaux 1s2s ${}^{3}S_{1}$ et 1s2s ${}^{1}S_{0}$ qui est relativement longue et, de ce fait, ces niveaux peuvent être appréciablement peuplés et leurs probabilités de se désexciter par impact d'électrons peuvent devenir grandes. Par exemple, la durée de vie radiative du niveau 1s2s ${}^{3}S_{1}$ liée à son déclin par transition magnétique vers le niveau fondamental ${}^{1}S_{0}$ s'étend de 20.6 ms dans C⁴⁺ à 2.78 μ s dans Si¹²⁺ [1]. Tandis que celle du niveau 1s2s ${}^{1}S_{0}$ qui décline vers 1s² ${}^{1}S_{0}$ par transition à deux photons dipolaire électrique décroît plus lentement, de 3.03 μ s à 11.5 ns entre ces deux mêmes ions [2]. Pour ces ions de numéro atomique Z entre 6 et 14, le rapport d'intensité de la raie de résonance *w* sur la raie d'intercombinaison *y* est très sensible à la densité électronique entre 10¹⁸ et 10²³ cm⁻³. C'est la raison pour laquelle ce rapport d'intensité est souvent été utilisé comme un puissant outil pour les diagnostics en densité d'électrons de divers plasmas Maxwelliens, particulièrement, ceux produit par laser [3-6].

II. Modèle Collisionnel-Radiatif (CR)

Dans l'approximation de l'ion isolé et du régime stationnaire, les populations des niveaux excités sont déterminées en résolvant un système d'équations couplées donné, dans le cadre du modèle CR:

$$N_{j}\left(\sum_{i< j}\left(N_{e}C_{j\rightarrow i}+A_{j\rightarrow i}\right)+\sum_{k>j}N_{e}C_{j\rightarrow k}\right)=\sum_{i< j}N_{i}N_{e}C_{i\rightarrow j}+\sum_{k>j}N_{k}\left(N_{e}C_{k\rightarrow j}+A_{k\rightarrow j}\right).$$
(1)

 N_j : la densité de population du niveau j.

 N_e : la densité des électrons libres du plasma.

 $A_{j \rightarrow i}$: la probabilité de transition radiative.

 $C_{j \rightarrow i}$: le coefficient de taux de transition collisionnelle du niveau *j* vers *i*.

- Le coefficient de taux d'excitation de $i \rightarrow j$ (en cm³/s) avec $\Delta E_{ij} > 0$ est donné par l'expression:

$$C_{j\to i} = \frac{8.63 \times 10^{-6}}{g_j T_e^{\frac{1}{2}}} e^{\frac{-\Delta E_{ji}}{kT_e}} \int_0^\infty \Omega_{ji} e^{\frac{-\varepsilon_i}{kT_e}} d\left(\frac{\varepsilon_i}{kT_e}\right).$$
 (2)

g_j: le poids statistique du niveau initial j.

 T_e : la température associée aux électrons.

 Ω_{ij} : la force de collision.

- le coefficient de taux de désexcitation collisionnelle peut être déduit du coefficient $C_{i \rightarrow j}$ par la relation suivante:

$$g_i C_{i \to j} = g_j C_{j \to i} e^{-\Delta E_{ij} / kT_e}(3)$$

- les rapports d'intensité de raies peuvent être déduits par la relation

$$\frac{I_{i \to g}}{I_{j \to g}} = \frac{N_i}{N_j} \frac{A_{i \to g}}{A_{j \to g}}....(4)$$

III. Données atomiques pour le rapport des raies w/y de l'ion Si¹²⁺

Nous avons calculé le rapport d'intensité w/y en fonction de la densité des électrons en appliquant un modèle C-R. Dans cette partie, après avoir décrit les principales caractéristiques des raies w et y de l'ion Si¹²⁺, nous exposerons un ensemble de tableaux donnant toutes les données atomiques nécessaires pour le calcul du rapport d'intensité. Parmi ces données atomiques, il y a les énergies des niveaux de Si¹²⁺, les probabilités de transition radiative entre les différents niveaux excités 1s2*l* et 1s3*l*.

III.1. Raie de résonance w

La raie de résonance désignée par *w* est émise par l'ion héliumoïdes, et correspond à la transition $1s2p {}^{1}P_{1} \rightarrow 1s^{2} {}^{1}S_{0}$ qui est de type dipolaire électrique E1 ($\Delta J=1$, $\Delta L=1$, $\Delta S=0$). Pour l'ion considéré Si¹²⁺, la longueur d'onde de cette raie est 6.6467Å [7].

Dans le cas des plasmas peu denses, le niveau supérieur $1s2p {}^{1}P_{1}$ est peuplé principalement par excitation collisionnelle à partir du niveau fondamental $1s^{2} {}^{1}S_{0}$, et se dépeuple essentiellement par émission spontanée vers le niveau $1s^{2} {}^{1}S_{0}$ avec la probabilité $A = 4.013 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}$ [7]. Lorsque le plasma devient relativement dense, le niveau $1s2p {}^{1}P_{1}$ peut aussi être peuplé par excitation collisionnelle à partir de niveaux excités, principalement à partir du niveau voisin $1s2s {}^{1}S_{0}$. Quant au dépeuplement du niveau $1s2p {}^{1}P_{1}$, nous verrons ultérieurement qu'il commence à devenir appréciable lorsque la densité dépasse -2×10^{22} cm⁻³.

III.2. Raie d'intercombinaison *y*

Dans les ions héliumoïdes de charge nucléaire Z de plus en plus grande, l'interaction spin-orbite et d'autres interactions relativistes deviennent de plus en plus importantes et causent ainsi un mélange de plus en plus appréciable des niveaux singulets et triplet 1s2p $^{1}P_{1}$ et $^{3}P_{1}$. Ceci entraîne que la probabilité de transition E1 d'intercombinaison ($\Delta S=1$) du niveau 1s2p $^{3}P_{1}$ vers le niveau fondamental $1s^{2}$ $^{1}S_{0}$, qui correspond à la raie d'intercombinaison appelée y, croît rapidement lorsqu'on se déplace le long de la séquence iso-électronique et peut devenir plus grande que la probabilité de transition permise vers 1s2s $^{3}S_{1}$ dès que Z dépasse la valeur 7 (c'est à dire pour l'ion N⁵⁺) [8].

Dans le cas de Si¹²⁺ considéré ici, la probabilité de transition d'intercombinaison 1s2p ${}^{3}P_{1} \rightarrow 1s^{2} {}^{1}S_{0}$ est, d'après les calculs de Johnson *et al* [9], égale à 1.570 ×10¹¹ s⁻¹ alors que la probabilité de transition permise 1s2p ${}^{3}P_{1} \rightarrow 1s2s {}^{3}S_{1}$ est égale à 1.592 ×10⁸ s⁻¹. On peut remarquer un facteur de 10³ en faveur de la probabilité d'intercombinaison.

<u> </u>	
Niveau	E (keV)
$1s^{2} S_0$	0
$1s2s {}^{3}S_{1}$	1.8402
$1s2p {}^{3}P_{0}$	1.8541
$1s2p {}^{3}P_{1}$	1.8545
$1s2s^{-1}S_0$	1.8547
$1s2p {}^{3}P_{2}$	1.8554
$1s2p^{-1}P_{1}$	1.8654
$1s3s {}^{3}S_{1}$	2.1767
$1s3p {}^{3}P_{0}$	2.1806
$1 s 3 s^{-1} S_0$	2.1806
$1s3p {}^{3}P_{1}$	2.1807
$1s3p {}^{3}P_{2}$	2.1807
$1s3d^{3}D_{1}$	2.1829
$1s3d^{3}D_{2}$	2.1829
$1s3d^{3}D_{3}$	2.1830
$1s3d {}^{1}D_{2}$	2.1831
$1s3p {}^{1}P_{1}$	2.1837

Tableau 1: Les énergies des 17 premiers niveaux de l'ion Si¹²⁺

j→i	Transition	Probabilité	j→i	Transition	Probabilité
		$A_{ji} (s^{-1})$	-		$A_{ji} (s^{-1})$
4→1	$1s2p {}^{3}P_{1} \rightarrow 1s^{2} {}^{1}S_{0}$	1.352×10^{11}	15→6	$1s3d {}^{3}D_{3} \rightarrow 1s2p {}^{3}P_{2}$	1.893×10^{12}
7→1	$1s2p {}^{1}P_{1} \rightarrow 1s^{2} {}^{1}S_{0}$	4.013×10 ¹³	10→7	$1s3s {}^{1}S_{0} \rightarrow 1s3p {}^{1}P_{1}$	2.492×10^{11}
17→1	$1s3p {}^{1}P_{1} \rightarrow 1s^{2} {}^{1}S_{0}$	1.157×10^{13}	13→7	$1s3d {}^{3}D_{1} \rightarrow 1s2p {}^{1}P_{1}$	2.450×10 ⁹
3→2	$1s2p {}^{3}P_{0} \rightarrow 1s2s {}^{3}S_{1}$	1.466×10^{8}	14→7	$1s3d {}^{3}D_{2} \rightarrow 1s2p {}^{1}P_{1}$	1.625×10^{11}
4→2	$1s2p {}^{3}P_{1} \rightarrow 1s2s {}^{3}S_{1}$	1.595×10^{8}	16→7	$1s3d {}^{1}D_2 \rightarrow 1s2p {}^{1}P_1$	1.691×10^{12}
6→2	$1s2p^{3}P_{2} \rightarrow 1s2s^{3}S_{1}$	1.936×10 ⁸	9→8	$1s3p {}^{3}P_{0} \rightarrow 1s3s {}^{3}S_{1}$	1.864×10^{7}
9→2	$1s3p {}^{3}P_{0} \rightarrow 1s2s {}^{3}S_{1}$	6.300×10^{11}	11→8	$1s3d {}^{3}P_{1} \rightarrow 1s3s {}^{3}S_{1}$	2.039×10^{7}
11->2	$1s3p {}^{3}P_{1} \rightarrow 1s2s {}^{3}S_{1}$	6.282×10^{11}	12→8	$1s3d {}^{3}P_{2} \rightarrow 1s3s {}^{3}S_{1}$	2.511×10^{7}
12→2	$1s3p {}^{3}P_{2} \rightarrow 1s2s {}^{3}S_{1}$	6.323×10^{11}	12→9	$1s3d {}^{3}P_{2} \rightarrow 1s3p {}^{3}P_{0}$	1.891×10^{6}
17→2	$1s3p {}^{1}P_{1} \rightarrow 1s2s {}^{3}S_{1}$	2.532×10^{9}	17→10	$1s3p {}^{1}P_{1} \rightarrow 1s3s {}^{1}S_{0}$	9.217×10^{6}
8→3	$1s3s {}^{3}S_{1} \rightarrow 1s2p {}^{3}P_{0}$	2.479×10^{10}	13→11	$1s3d {}^{3}D_{1} \rightarrow 1s3p {}^{3}P_{1}$	1.207×10^{6}
13->3	$1s3d^{3}D_{1} \rightarrow 1s2p^{3}P_{0}$	1.063×10^{12}	14→11	$1s3d {}^{3}D_{2} \rightarrow 1s3p {}^{3}P_{1}$	2.097×10^{5}
8→4	$1s3s^3S_1 \rightarrow 1s2p\ ^3P_1$	7.383×10^{10}	16→11	$1s3d {}^{1}D_{2} \rightarrow 1s3p {}^{3}P_{1}$	2.184×10^{5}
13→4	$1s3d^{3}D_{1} \rightarrow 1s2p^{3}P_{1}$	7.921×10^{11}	14→12	$1s3d {}^{3}D_{2} \rightarrow 1s3p {}^{3}P_{2}$	4.509×10^{5}
14->4	$1s3d^{3}D_{2} \rightarrow 1s2p^{3}P_{1}$	1.323×10^{12}	15→12	$1s3d {}^{3}D_{3} \rightarrow 1s3p {}^{3}P_{2}$	2.365×10^{6}
15→4	$1s3d^{1}D_{2} \rightarrow 1s2p^{3}P_{1}$	1.098×10^{11}	16→12	$1s3d {}^{1}D_{2} \rightarrow 1s3p {}^{3}P_{2}$	7.925×10^4
7→5	$1s2p^1P_1 \rightarrow 1s2s^{-1}S_0$	6.702×10^7	17→14	$1s3p {}^{1}P_{1} \rightarrow 1s3d {}^{3}D_{2}$	1.402×10^4
11→5	$1s3p^{3}P_{1} \rightarrow 1s2s^{-1}S_{0}$	2.496×10^{9}	17→16	$1s3p {}^{1}P_{1} \rightarrow 1s3d {}^{1}D_{2}$	6.021×10^4
17→5	$1s3p^1P_1 \rightarrow 1s2s^{-1}S_0$	6.533×10 ¹¹	14→6	$1s3d {}^{3}D_{2} \rightarrow 1s2p {}^{3}P_{2}$	4.174×10^{11}
8→6	$1s3s {}^{3}S_{1} \rightarrow 1s2p {}^{3}P_{2}$	1.223×10^{11}	13→6	$1s3d {}^{3}D_{1} \rightarrow 1s2p {}^{3}P_{2}$	5.253×10^{10}
14->4	$1s3d^{3}D_{2} \rightarrow 1s2p^{3}P_{1}$	1.323×10^{12}	16→6	$1s3d ^{1}D_{2} \rightarrow 1s2p ^{3}P_{2}$	5.560×10^{10}

 Tableau 2 : Probabilités de transition radiative (en s⁻¹) de type dipolaire électrique (E1) à partir de tous les niveaux 1s2l et 1s3l considérés dans le tableau 1 vers des niveaux inférieurs dans l'ion Si¹²⁺ obtenus du site web www-amdis.aiea.org.

Tableau 3 : Probabilités de transition radiative (en s ⁻¹) prises de l'article de Johnson, Plante et
Sapirstein [10].

$j \rightarrow i$	Transition	<i>Probabilité</i> A_{ji} (s ⁻¹)
2→1	$1s2s {}^{3}S_{1} \rightarrow 1s^{2} {}^{1}S_{0} (M1)$	3.598×10 ⁵
4→1	$1s2p {}^{3}P_{1} \rightarrow 1s^{2} {}^{1}S_{0} (E1)$	1.570×10^{11}
6→1	$1s2p {}^{3}P_{2} \rightarrow 1s^{2} {}^{1}S_{0} (M2)$	3.873×10^{7}
7→1	$1s2p {}^{1}P_{1} \rightarrow 1s^{2} {}^{1}S_{0} (E1)$	3.755×10^{13}
3→2	$1s2p {}^{3}P_{0} \rightarrow 1s2s {}^{3}S_{1} (E1)$	1.524×10^{8}
4→2	$1s2p {}^{3}P_{1} \rightarrow 1s2s {}^{3}S_{1} (E1)$	1.592×10^{8}
6→2	$1s2p {}^{3}P_{2} \rightarrow 1s2s {}^{3}S_{1} (E1)$	1.919×10 ⁸

Tableau 4 : Proba	abilité de transition	radiative à deux	photons (en s	¹) prise de l'	'article de
	Derev	ianko et Johnson	[11].		

.

$j \rightarrow i$	Transition	<i>Probabilité</i> A_{ji} (s ⁻¹)
5→1	$1s2s {}^{1}S_{0} \rightarrow 1s^{2} {}^{1}S_{0} (2E1)$	8.685×10^7

III. Résultats numériques et discussions Pour des densités inférieures à 10^{19} cm⁻³, le rapport α prend des valeurs comprises entre 1.1 et 2.01 dans l'intervalle de température de 10^6 à 8×10^6 K. Lorsque la densité

électronique augmente à partir de ~ 10^{20} cm⁻³, on peut remarquer que le rapport α croît rapidement avec la densité électronique et atteint la valeur approximative de 173.01 à 10^{22} cm⁻³ pour la température $T_e = 6 \times 10^6$ K. Ceci découle de la croissance considérable de la population du niveau 1s2p ¹P₁ dû à l'excitation collisionnelle à partir de la plupart des niveaux dont le niveau métastable 1s2s ¹S₀.



Figure 1: Rapport d'intensité des raies *w* et *y* émises par l'ion héliumoïde Si¹²⁺ en fonction de la densité électronique N_e du plasma et pour la température électronique $T_e=6\times 10^6$ K et $T_e=8\times 10^6$ K. Ce rapport est calculé dans le cadre du modèle collisionnel-radiatif incluant les 7 premiers niveaux de la couche *n*=2.

Nous avons reporté sur la figure 2 les résultats de α déjà présentés sur la figure précédente calculés en les deux températures 6×10^6 et 8×10^6 K, en même temps que les résultats de α calculés en tenant compte aussi de la contribution des cascades au peuplement de tous les niveaux triplets n = 2 à partir des sept niveaux triplets appartenant à la couche n=3 qui sont 1s3s ${}^{3}S_{1}$, 1s3p ${}^{3}P_{0,1,2}$ et 1s3d ${}^{3}D_{1,2,3}$, ${}^{1}D_{2}$ et 1s3p ${}^{1}P_{1}$ affin de mieux voir les effets des cascades venant des niveaux n=3. La comparaison entre les deux courbes de la figure 2 nous permet de dire que l'inclusion des cascades à partir des niveaux n=3 peut provoquer une augmentation significative du rapport α surtout à hautes densités. Cette augmentation de α dans le domaine des grandes densités est due principalement aux cascades qui alimentent les niveaux $1s2p^{3}P_{1}$ et 1s2s ${}^{3}S_{1}$.



Figure 2: Rapport *w/y* d'intensité de raies émises par l'ion Si¹²⁺ en fonction de la densité électronique N_e du plasma pour la température électronique $T_e=6\times 10^6$ K et $T_e=8\times 10^6$ K. Les résultats sont présentés pour des calculs effectués dans le cadre du modèle collisionnel-radiatif incluant 7 niveaux (\blacksquare) et 17 niveaux (\blacklozenge).

VI. Conclusion

Nous avons étudié une méthode efficace de diagnostic de la densité d'électrons libres dans des plasmas chauds et relativement denses tels que ceux produits lors des interactions laser-solide. Cette méthode repose sur le rapport d'intensité α de la raie de résonance w sur celle d'intercombinaison y émises par des ions héliumoïdes fortement chargés. Nos calculs du rapport d'intensité α ont été effectués pour l'ion émetteur de silicium Si¹²⁺ dans le cadre du modèle collisionnel-radiatif incluant un certain nombre de niveaux provenant des configurations 1s², 1s2s, 1s2p, 1s3s, 1s3p, 1s3d. Nous avons pris en compte explicitement l'excitation collisionnelle à partir aussi bien du niveau fondamental 1s²⁻¹S₀ que de tous les niveaux excités considérés. Il a été aussi tenu compte de la possibilité de désexcitation radiative spontanée à partir de tous les niveaux 1s2*l* et 1s3*l* excités (${}^{3}S_{1}$, ${}^{1}S_{0}$, ${}^{3}P_{0,1,2}$, ${}^{3}D_{1,2,3}$, ${}^{1}D_{2}$, et ${}^{1}P_{1}$). Les calculs ont été réalisés en fonction de la densité électronique N_{e} du plasma émissif supposé être Maxwellien, dans le domaine 10¹⁸–10²³ cm⁻³ et pour diverses valeurs de la température électronique T_{e} comprises entre 10⁶ et 8×10⁶ K, pour lesquelles l'ion Si¹²⁺ est relativement abondant. Les données atomiques de collision utilisées dans cette étude sont considérées de bonne qualité puisqu'elles ont été obtenues en exécutant des programmes enligne réputés assez fiables.

Les résultats que nous avons obtenus ont montré une forte sensibilité du rapport d'intensité w/y par rapport à la variation de la densité d'électrons dans le domaine 10^{18} - 10^{23} cm⁻³, tandis que ce rapport d'intensité varie légèrement avec la température électronique. Nous avons trouvée que dans la limite des hautes densités ($N_e \ge 10^{18}$ cm⁻³), le rapport d'intensité w/y prend la valeur 2.01 à la température 6×10^6 K, puis, il augmente à 19.6 lorsque la densité augmente à 10^{21} K cm⁻³ et à 636.74 lorsque la densité s'élève à 10^{23} cm⁻³.

V. Références

[1] W.R. Johnson, D.R. Plante et J. Sapirstein, *Advances in Atomic, Molecular, and Optical Physics*, edited by B. Bederson et H. Walther (Acadimic, San Diego, 1995) Vol.**35**, p.255.

[2] A. Derevianko et W.R. Johnson, Phy. Rev. A 56, 1288(1997).

[3] A.V. Vinogradov, I. Y. Skobelev and E. A Yuko. Sov. J. Quantum Electron. 5 630(1975).
[4] J.C. Weisheit, C. B. Tarter, J.H. Scofield and L.M. Richards. J. Quant. Spectrosc .Radiat.

Transfer **16** 659(1976).

[5] I.Y. Skobelev, A. V. Vinogradov and E. A. Yukov. Phys. Scr. 18 78(1978).

[6] V.A. Boiko, A.Y. Faenov, S.Y. Hahalin, S.A. Pikuz., K.A. Shilov and I. Y. SkobelevJ. Phys. B: At. Mol. Phys. **16** 213(1983).

[7] le site www-amdis.aiea.org.

- [8] D. Porquet. J. Dubau, Astron. Astrophys. Suppl. Ser. 143, 495 (2000).
- [9] Johnson, Plante et Sapirstein. Ad. At. Mol. Ppt. Phys. 35, 255(1995).
- [10] Derevianko et Johnson, PRA 56, 1288 (1997).
- [11] H. Zhang et D. H. Sampson, Astrophys. J. Suppl. Ser. 63, 487 (1987).